



BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, E., FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI のF, BJ, CF, CR, CI, CM, RA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTカセットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(57) 要約: 高誘電率ゲート絶縁膜とメタルゲート電極の組み合わせ技術におけるCMOSトランジスタのしきい値制御の問題を改善し、素子の信頼性を低下させることなく特性を大幅に向上させることが可能な半導体装置を提供する。高誘電率材料を用いたゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜に接している側の組成が $MxSi_{1-x}$ ($0 < x < 1$) で表される金属Mのシリサイドを主成分としたゲート電極を備え、P型MOSFETでは前記金属Mのシリサイドが $x \geq 0.5$ 、N型MOSFETでは金属Mのシリサイドが $x \leq 0.5$ であることを特徴とする半導体装置である。